

Title	ストロボ走査電子顕微鏡による集積回路の波形観測に関する研究
Author(s)	中前, 幸治
Citation	
Issue Date	
Text Version	ETD
URL	http://hdl.handle.net/11094/1368
DOI	
rights	
Note	

Osaka University Knowledge Archive : OUKA

<https://ir.library.osaka-u.ac.jp/>

Osaka University

氏名	中 前 幸 治
学位の種類	工 学 博 士
学位記番号	第 5 6 7 4 号
学位授与の日付	昭和 57 年 3 月 25 日
学位授与の要件	工 学 研 究 科 電 子 工 学 専 攻 学位規則第 5 条第 1 項該当
学位論文題目	ストロボ走査電子顕微鏡による集積回路の波形観測 に関する研究
論文審査委員	(主査) 教 授 裏 克 己 教 授 松 尾 幸 人 教 授 小 山 次 郎

論 文 内 容 の 要 旨

本論文は、ストロボ走査電子顕微鏡（ストロボSEM）による集積回路の波形観測に関する研究をまとめたものであり、6章から構成されている。

第1章では、ストロボSEMによる半導体集積回路の波形観測に関する問題点と研究の現状とを述べ、本論文の位置づけをしている。

第2章では、ストロボSEMの原理と本研究に用いた装置の概略を述べ、さらに波形観測のための改良について触れている。一つは、波形観測のさい位相を電氣的に精度よく変化させるためのPLL型移相器の試作と付加であり、他はS/N比の改善と観測時間短縮のための信号処理機能の付加である。

第3章では、MOS構造における低エネルギー照射電子の異常透過の測定について述べている。パッシベーション膜付MOSトランジスタに5～20KeVの電子を照射し、そのとき生ずる臨界電圧の変化からゲート酸化膜中に吸収されるエネルギーを測定している。この結果から、電子の飛程とそのストラグリングを考慮しても説明できない深部でエネルギー吸収のあることを示している。

第4章では、SEMで表面電位を測定するさい問題となる局所電界効果についての理論解析と実験を述べている。対象としたのは通常のSEM検出系および引き出し電界をもつ分光器検出系である。その結果から、引き出し電界を大きくしても局所電界効果が大幅には減らず、また電極寸法への依存性は引き出し電界への依存性と等価であることを示している。

第5章では、バイポーラIC—LSIおよびMOS—LSIの波形観測の実例を示し、素子の故障個所や動作限界の原因の追求などにストロボSEMが有用であることを示している。

第6章は結論である。

論文の審査結果の要旨

ストロボSEMは、超高密度化と超高速化の進歩が著るしい半導体集積回路の動作解析に必須の装置になりつつある。これを用いて電位の定量的測定を行なうさい、隣接電極の電位変化による電位コントラスト信号量の変化、すなわち局所電界効果が最も基本的な問題となっているが、電位コントラスト生成機構そのものが十分解明されていなかった。また素子特性が変化しないような電子照射条件の設定についても十分の知見が得られていない。

本論文では、SEMの二次電子検出系における二次電子の軌道解析から信号電流を計算する方法を考案し、いくつかのモデルについて計算と実験とから電位コントラスト生成ならびに局所電界効果を定量的に解明している。また、これまで知られている電子の飛程とそのストラグリングだけでは説明不能な深部まで電子照射効果が及んでいることを実験的に示している。

このように本論文は電子工学の進歩に貢献するところ大である。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。